

Application Note

MCU+SDK 的 xSPI 定制闪存调试指南



Vaibhav Kumar, Nikhil Jain

摘要

本应用手册提供了有关使用 MCU+SDK 在 TI Sitara™ 处理器上启动定制闪存器件的指导。本文档解决了开发人员在定制电路板（使用的闪存器件不同于 TI 评估模块 (EVM) 上提供的闪存器件）上所面临的挑战。

本文档概述了集成、配置和验证新闪存器件以验证能否在 TI 软件生态系统中可靠运行所需的步骤。目标受众包括工程师和开发人员，他们正在设计定制硬件，并需要通过 SPI/QSPI/OSPI 接口启用闪存通信。

阅读本应用手册有助于缩短启动时间并大幅减少常见集成问题，从而加快定制闪存配置的开发和调试速度。

内容

1 简介.....	2
2 术语.....	2
3 了解引导模式和闪存兼容性.....	2
4 闪存集成和 SysConfig 设置.....	3
4.1 FLASH 参数.....	4
4.2 OSPI 参数.....	8
5 常见启动问题和调试.....	9
5.1 引导失败.....	9
5.2 已知勘误表.....	9
5.3 闪存初始化失败.....	9
5.4 闪存读取失败.....	10
5.5 闪存编程故障.....	10
6 请求 OSPI 和 FLASH 支持的检查清单.....	11
7 摘要.....	11
8 参考资料.....	11

商标

Sitara™ is a trademark of Texas Instruments.
所有商标均为其各自所有者的财产。

1 简介

在嵌入式系统中，外部闪存存储器广泛用于存储引导加载程序和应用程序代码。AM64x、AM62x、AM62P 和 AM62Dx 等 Sitara 处理器支持多个串行接口（如 OSPI 和 QSPI），用于连接外部 NOR/NAND 闪存器件。在使用 MCU+SDK 启动定制电路板期间，用户在连接新闪存器件时通常会面临一些挑战，例如配置 SysConfig 参数、读取器件 ID 或启用 PHY 模式。

本应用手册介绍了如何使用 SysConfig 配置闪存参数，解释常见错误日志以及解决闪存识别和 PHY 启用期间出现的问题。

2 术语

QSPI：四线串行外设接口

OSPI：八线串行外设接口

xSPI：扩展串行外设接口

NVCR：非易失性配置寄存器

VCR：易失性配置寄存器

DDR：双倍数据速率

SDR：单倍数据速率

QE：四路使能位

DAC：直接存取控制器

3 了解引导模式和闪存兼容性

可以在[此处](#)的技术参考手册中找到 ROM 支持的串行 NOR/NAND 闪存的各种引导模式。每种引导模式都描述了 ROM 用于发出读取命令的协议。协议因各种引导模式而异。例如，对于 SPI（协议 1S-1S-1S）引导模式，ROM 发出读取命令 0x03（8 位），后跟 3 字节（24 位）地址且无虚拟周期。

如果根据引导模式的说明，则认为闪存支持引导。闪存支持以下参数：

1. 协议。
2. 读取命令。
3. 读取命令和地址的字节数（3 字节/4 字节）。
4. 读取的虚拟周期数。

对于定制闪存，要获取这些值，请参阅闪存特定数据表。在闪存数据表中，这些值包含在名为 *Command Set*、*Command Table*、*Instruction Set*、*Instruction Table*、*Transaction Set*、*Transaction Table* 的部分下。

4 闪存集成和 SysConfig 设置

SysConfig 是一款配置工具，旨在简化硬件和软件配置挑战，从而加速软件开发。

在 MCU+SDK 中，对于定制闪存，需要修改的部分如 图 4-1 中所示。

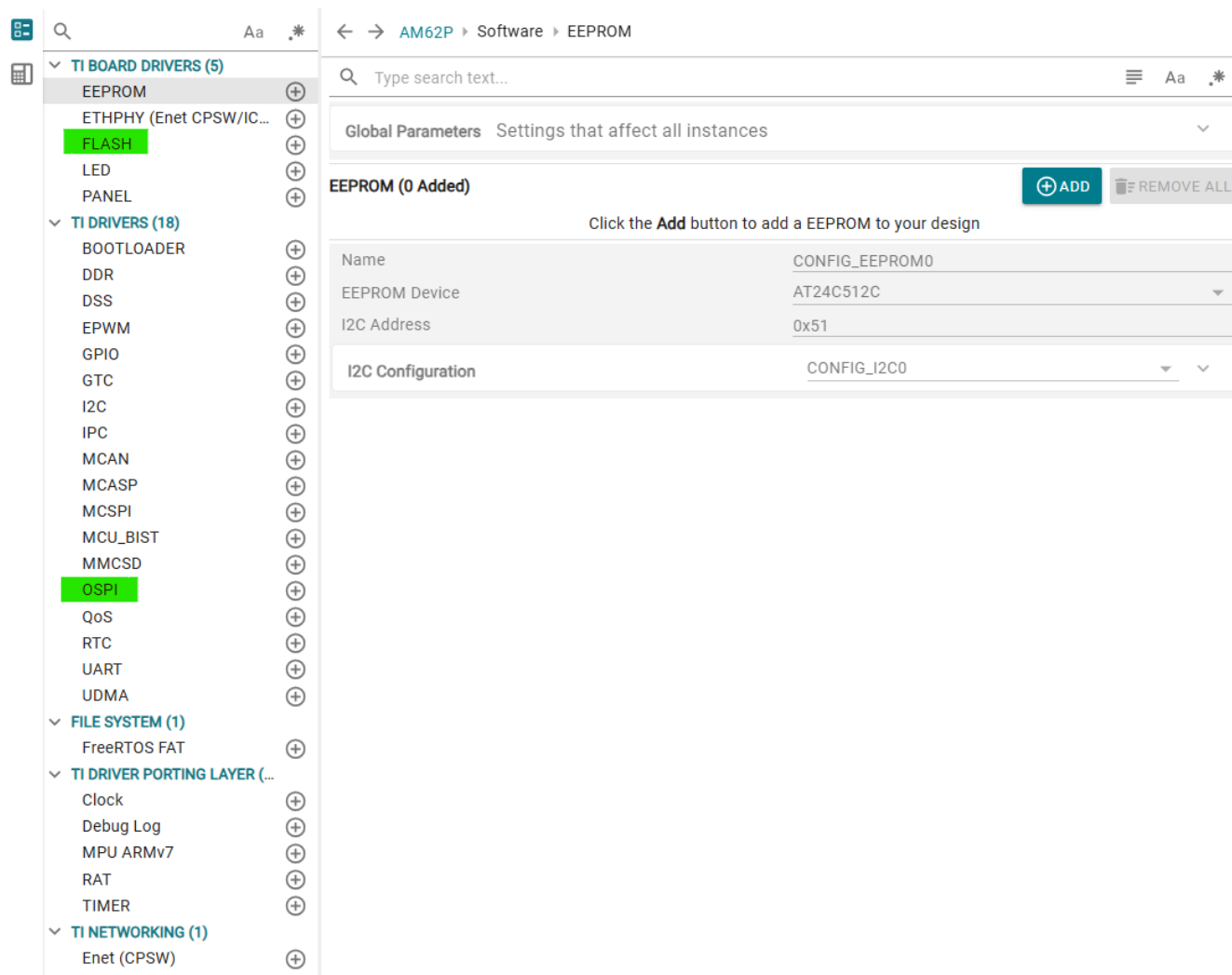


图 4-1. 显示 FLASH 和 OSPI 部分的 SysConfig GUI

要获取定制闪存配置值，请按照[此处](#)的指南进行操作。本指南目前适用于串行 NOR 闪存。对于串行 NAND 闪存，必须从闪存数据表中获取配置值。

获得这些值后，可以用获得的值填充 FLASH 部分。这些值可以手动填充，也可以以 json 格式上传。使用闪存数据表中所述的值运行 OSPI 闪存诊断示例，验证获得的值。以下各节展示了 FLASH 和 OSPI 部分中的各种参数。

4.1 FLASH 参数

对于每个参数，单击 ? 可了解相关说明。

有关图 4-2 的说明：

1. **闪存器件**：如果闪存不是 TI EVM 上的默认闪存之一，请选择定制闪存。
2. **闪存名称**：写入正在使用的闪存的名称，例如 *W25Q512JV*。
3. **协议**：从列出的协议中选择闪存也支持的协议之一。这将分别配置要用于命令、地址和数据的行数。它还指定数据速率，即 **DDR** (双倍数据速率) 或 **SDR** (单倍数据速率)。例如，**4S-4D-4D** 表示 4 行分别用于命令、地址和数据。对于命令，数据在上升沿/下降沿锁存，但对于地址和数据，数据在上升沿和下降沿均锁存。

Serial Flash Configuration

Flash Device: Custom Flash

Flash Type: Serial Nor Flash

Flash Name: NAME OF THE FLASH
✖ Provide a valid C name

Protocol: 8D-8D-8D

Basic Flash Configuration

Flash Size In Bytes

Flash Page Size In Bytes

Flash JEDEC Manufacturer ID

Flash JEDEC Device ID

Erase Configurations

Flash Block Size In Bytes

Flash Sector Size In Bytes

Block Erase CMD (3B)

图 4-2. 基本闪存配置

有关图 4-3 的说明：

1. **闪存 JEDEC 制造 ID**：特定制造商的此值相同。
2. **闪存 JEDEC 器件 ID**：该值因同一制造商的闪存型号而异。例如，Winbond 闪存对于分别在 1.8V 和 3.6V 电压下运行的闪存，具有不同的器件 ID。还有其他一些参数具有不同的闪存器件，这些参数可在闪存数据表中找到。
3. **虚拟时钟 (CMD)** 和 **虚拟时钟 (读取)**：虚拟时钟用于同步闪存读取。也可以从闪存数据表中获取这些值。注意指定为 *虚拟周期虚拟时钟* 的部分。请注意，该字段指定在 **OSPI** 控制器端设置的值。要在闪存结束时设置虚拟周期/时钟值，需要对闪存配置寄存器进行写入。请参阅 **虚拟周期配置** 字段。
4. **四路使能类型**：一些 QSPI 闪存具有 **QE** (四路使能) 位。对于 **1S-1S-4S**、**4S-4S-4S** 和 **4S-4D-4D** 等协议，需要启用该位。
5. **QPI 序列** 和 **OPI 序列**：要分别启用 **4-4-4** 模式和 **8-8-8** 模式，请使用这些字段。
6. 有关闪存的块大小和扇区大小，请参阅闪存数据表。可从诊断日志中获取相同的命令，但最好从数据表中进行验证。
7. **SysConfig** 允许用户设置扇区大小和块大小，如果闪存支持不同的扇区/块大小，用户可以根据应用指定特定的扇区/块大小。
8. **(3B)** 和 **(4B)** 是指闪存的 3 字节和 4 字节寻址模式。这基本上指定了必须发送多少个地址字节。对于小于 16MB 的闪存，只需 3 个字节寻址即可满足整个闪存区域的需求。

Basic Flash Configuration	
Flash Size In Bytes	67108864
Flash Page Size In Bytes	256
Flash JEDEC Manufacturer ID	0x34
Flash JEDEC Device ID	0x5B1A

Erase Configurations	
Flash Block Size In Bytes	262144
Flash Sector Size In Bytes	4096
Block Erase CMD (3B)	0xDC
Block Erase CMD (4B)	0xDC
Sector Erase CMD (3B)	0x21
Sector Erase CMD (4B)	0x21

Protocol Enable Configuration	
Read Command	0xEE
Write/Page Program Command	0x12
Mode Clocks (CMD)	0
Mode Clocks (READ)	0
Dummy Clocks (CMD)	4
Dummy Clocks (READ)	21
Quad Enable Type	0
Octal Enable Type	0
QPI Sequence	0x00
OPI Sequence	0x00

图 4-3. 基本闪存擦除和协议配置

有关图 4-4 的说明：

1. **协议配置**：协议通常指定用于命令、地址和数据的行数。为了使闪存以特定协议运行，该部分需要被填满。
2. **虚拟周期配置**：为了使闪存以特定协议运行，闪存配置寄存器需要配置虚拟周期。这是闪存侧设置，OSPI 控制器的设置在 **虚拟时钟（读取）** 字段下定义。
3. **STR/DTR 配置**：可以设置此位以使闪存存在 SDR/DDR 模式下运行。

Protocol Configuration	
Config Is Using Addressed Reg	<input checked="" type="checkbox"/>
Address Of Config Reg	0x00800006
CMD To Read Config Reg	0x65
CMD To Write To Config Reg	0x71
Register Data	
Dummy Cycle Configuration	
STR/DTR Configuration	

图 4-4. 协议、虚拟周期和 STR/DTR 配置

有关图 4-5 的说明：

让我们仔细了解这一点。假设配置寄存器的值为 10111101b。如果位[5:2] 需要更新为 1001b，则数据移位位、数据二进制掩码和要写入的数据中的值将分别为 2、0x3C 和 9。使用逻辑 (value & ~(Data Binary Mask)) 对原始值 10111101b 执行掩码操作。这样会得到值 10000001b。现在，将按 (value | (Data To Be Written << Data Shift Bits)) 执行移位操作。最终值变为 10100101b，因此会写入配置寄存器。

Register Data

Data Shift Bits

0

Data Binary Mask

0x01

Data To Be Written

1

图 4-5. 寄存器数据字段配置

有关图 4-6 的说明：

字段一目了然。可以参考闪存数据表来设置正确的值。

Advanced Flash Configuration

Flash Reset Type ②

0x10

Description

Flashes support different types of software reset sequences to return the device to its default power-on state.

Here 'x' can be 0 or 1.

000000 : Soft Reset Not Supported xxxxx1 : Drive 0x0F on all 4 data wires for 8 clocks xxxxx1x : Drive 0x0F on all 4 data wires for 10 clocks If device is in 4 byte addressing xxx1xx : Drive 0x0F on all 4 data wires for 16 clocks xx1xxx : Issue instruction 0xF0 x1xxxx : Issue 0x66 for reset enable, and 0x99 for reset

Flash Device Busy Type ②

LEGACY POLLING OF SR

Description

Flashes support different ways to poll the device's busy status. Two main ways supported as per JESD216D are:

- 1. Polling bit 7 of flag status register using 0x70 read command, bit value = 1 means ready
- 2. Legacy method of polling the status register RDSR bit 0 (WIP bit), bit value = 0 means ready

Choose the appropriate option for your flash. For most flashes it is option 2.

图 4-6. 高级闪存配置

有关图 4-7 的说明：

可以在闪存数据表中找到所有这些值。请参阅“闪存数据表”中的“读取器件 ID/读取制造 ID 事务表”。

JEDEC ID Read Configuration

Read ID CMD

0x9F

Number Of Bytes To Read

3

Number Of Dummy Cycles In Quad Mode

0

Number Of Dummy Cycles In Octal Mode

4

图 4-7. JEDEC ID 读取配置

有关图 4-8 的说明：

1. **WIP 位**和 **WEL 位**：这些位指的是闪存状态寄存器中的“正在写入”和“写入使能锁存”位。

2. **四字节寻址**：如前所述，如果闪存大小大于 16MB，则需要执行此操作，并且闪存支持用于 (4B) 寻址的特定命令。
3. **命令扩展类型**：假设要发送的命令为 0x9F。因此，在以下情况下：
 - a. NONE：发送 0x9F。
 - b. REPEAT：发送 0x9F, 0x9F。
 - c. INVERSE：发送 0x9F, 0x60 (0x9F 的反码)。
4. Quirks 函数用于定义自定义 API，该 API 会对闪存的配置寄存器进行其他更改。目前，它定义为 *Flash_quirkSpansionUNHYSADisable*。此函数基本上会在 TI EVM 上禁用 flash(S28HS512T) 的混合模式。

Write Enable CMD	0x06
Read Status Register CMD	0x05
WIP Bit	0
WEL Bit	1
WIP Read CMD (xSPI)	0x65
WIP Status Reg Addr (xSPI)	0x00800000
WIP Bit (xSPI)	0
Chip Erase Command	0xC7
Flash Busy Timeout	256000000
Page Program Timeout	512
Enable 4 Byte Addressing	<input checked="" type="checkbox"/>

Four Byte Addressing ⓘ ^

Supported Addressing Modes	1
4 Byte Addressing Enable Sequence	0xA1

Command Extension Type	REPEAT ▼
------------------------	----------

Automatically Configure Flash ^

Load Flash Config From JSON LOAD FROM JSON

Quirks Function	Flash_quirkSpansionUNHYSADisable
-----------------	----------------------------------

图 4-8. 高级闪存配置 (续)

4.1.1 建议的方法

MCU+ SDK 提供了默认示例，可在以下路径中找到这些示例：MCU_PLUS_SDK_INSTALL_PATH/examples/drivers/osp. 一个此类示例是 OSPI Flash IO。如需有关此示例的更多详情，请单击[此处](#)。

成功运行此示例可确保所有基本闪存操作（擦除，写入和读取）都正常运行。这还可确认控制器和闪存器件之间的协议配置设置正确，以及 SysConfig 中配置的闪存参数按预期运行。

通过 OSPI Flash IO 示例验证闪存参数和协议的特定组合后，这些经过验证的设置便可重复用于其他应用，例如 UART Uniflash、引导加载程序（如 SBL OSPI）和类似项目。

总之，OSPI Flash IO 示例用作测试和配置闪存参数的可靠参考点，然后可将其应用于多个应用。

4.2 OSPI 参数

对于每个参数，单击 ? 可了解相关说明。

有关图 4-9 的说明：

1. **输入时钟频率 (Hz)：**这是基准时钟频率 (RCLK)。
2. **输入时钟分频器：**这是用于对基准时钟频率进行分频的分频器。OSPI 输出时钟 = 输入时钟频率/输入时钟分频器。
3. **芯片选择：**默认情况下，CS0 供 OSPI 控制器使用。
4. **协议：**此字段从 FLASH 部分的 *协议* 中填充。
5. **启用 DMA：**当事务大小大于 1KB 时，会进行 DMA 传输。
6. **启用 PHY 模式：**启用 PHY 模式（对于大于 50MHz 的时钟）。未选中时，将使用 TAP 模式。

OSPI (1 of 1 Added)

+

ADD

🗑️

REMOVE ALL

✓

CONFIG_OSPI0

📄

🗑️

Name	CONFIG_OSPI0
Input Clock Frequency (Hz)	166666666
Input Clock Divider	4
Chip Select	CS0
Protocol	8D-8D-8D
Enable DMA	<input type="checkbox"/>
Enable PHY Mode	<input type="checkbox"/>
Show Advanced Config	<input type="checkbox"/>
Instance Added By Bootloader	<input type="checkbox"/>

图 4-9. OSPI 配置

5 常见启动问题和调试

使用 MCU+SDK 处理闪存时的一些常见问题如下所示。

5.1 引导失败

出现与 ROM 发出 3 字节地址且闪存保持 4 字节寻址模式相关的引导失败很常见。要了解有关这方面的更多信息，请参阅 AM62P TRM 中的图 5-1。

When using a OSPI\XSPI\QSPI\SPI flash device greater than 128Mb which supports 3-byte and 4-byte addressing modes, a flash device package with a RESET signal must be used. The reason is that the ROM only uses 3 byte addressing mode (address is 24bits). To address the full memory address range, software will typically switch to 4-byte addressing mode. If a reset to the processor occurs (eg, due to a warm reset), the ROM will execute expecting 3-byte addressing mode, but the flash will have been left in 4-byte addressing mode. In order for the flash device to return to 3-byte addressing mode, it must be reset using this signal. This typically can be achieved by using the RESET signal on the flash memory device. The ROM does not issue a software reset command.

图 5-1. 关于复位信号的 AM62P TRM 部分

某些串行 NAND 闪存无法在串行 NAND 引导模式下引导，因为闪存中的参数页未存储在偏移地址 0x1 处。对于串行 NAND 闪存，参数页必须位于偏移地址 0x1 处，才能在串行 NAND 引导模式下成功引导。有关参数页偏移的信息可以从闪存数据表中获得。

对于串行 NOR 闪存，请始终确保验证引导模式说明中的命令。[了解引导模式和闪存兼容性](#)中对此进行了介绍。

使用 QSPI NOR 闪存时，常见引导模式是 QSPI 引导模式。请注意，对于 QSPI 引导模式，除了使引导模式说明与闪存数据表相符之外，还必须检查 QE 位。QE 是四路使能位。为了使 ROM 正确发出 1S-1S-4S，QSPI 闪存必须已设置 QE 位，因为 ROM 未设置该位。有些 QSPI 闪存默认情况下在出厂时设置了 QE 位。对于未设置 QE 位的 QSPI 闪存，TI 建议在 QSPI 引导模式下在引导之前设置 QE 位。

5.2 已知勘误表

一些 TI Sitara 处理器提供关于引导和闪存的已知勘误表。有关处理器特定勘误表的链接，请参阅[参考](#)。

1. i2351：所有 TI Sitara™ 处理器。
2. i2307：AM64x、AM62x 处理器。
3. i2366：AM62Ax、AM64x、AM62Dx、AM62x 处理器。
4. i2420：AM62Ax、AM64x、AM62Dx、AM62x 处理器。
5. i2189：所有 TI Sitara 处理器。
6. i2249：所有 TI Sitara 处理器。
7. i2383：所有 TI Sitara 处理器。

5.3 闪存初始化失败

在某些情况下，在 Flash_norOspiOpen 函数中会看到挂起，而在大多数情况下，会打印一个日志，表示 *FLASH open failed for instance 0 !!!*。这表明闪存尚未正确初始化。要通过此步骤，请参阅以下提示。

5.3.1 FLASH 和 OSPI SysConfig 值

重新访问 OSPI 和 FLASH 值，并查看是否有任何值写入错误。

5.3.2 闪存器件和制造 ID 读取失败

要调试读取 ID 故障，请通读以下[常见问题解答](#)。

5.3.3 PHY 故障

有两种与 PHY 调优相关的故障。选中 **Enable PHY Mode** 后，可能会遇到这两种故障。开始之前，请了解 [OSPI PHY 调优](#)和 [PHY 调优攻击向量](#)。

第一个故障是：“PHY enabling failed!!! Continuing without PHY...”；第二个故障是无法计算 OTP（最优调优点）。第一个故障发生在攻击向量已闪存但未正确读取时。因此，这反过来又指向第 5.3.1 节和第 5.3.2 节。第二个故障发生在 PHY 调优算法返回故障后。要调试此故障，可以考虑执行以下步骤：

1. 默认情况下，在 flash_nor_ospi、c 文件中，调用 OSPI_phyTuneDDR。如果在 STR 中配置了所使用的协议，则必须调用函数 OSPI_phyTuneSDR。
2. 要调试 PHY 调优故障，TI 建议生成 PHY 调优图。请参阅[此处的常见问题解答](#)。当发生 PHY 故障时，该图可用作参考，以查看 OTP 点的标记位置。

5.4 闪存读取失败

在某些情况下会发生闪存读取失败。这些情况包括：

1. 当 OSPI 控制器处于 DAC 状态时，使用特定地址范围映射闪存内容。[图 5-2](#) 显示了可用地址范围。默认情况下选择 0x60000000。当 MPU 区域 0x60000000 标记为缓存时会发生读取失败。这是用于闪存直接内存映射的区域。在软件中，这是通过将寄存器 0xFC40000 中的第 7 位 DAC 位设置为 1 来实现的。因此，0x60000000 不需要标记为“缓存”。
2. SysConfig 中的读取命令集对于所配置的协议不正确。一些闪存针对 3 字节和 4 字节寻址具有不同的读取命令。
3. 假设闪存上的数据为 00h 01h 02h 03h...，缓冲区中的读取值为 01h 02h 03h 04h...。这指向第 5.3.1 节，其中用于读取的虚拟时钟关闭值为 1。
4. DMA 相关问题包括由于读取缓冲区未缓存对齐而导致无法正确读取数据。

Address Range	Size	Description
0x40000000 - 0x4FFFFFFF	4 GB	External Memory Space (Region 0)
0x06000000 - 0x067FFFFFFF	128 MB	Boot Space (Region 1)
0x50000000 - 0x5FFFFFFF	4 GB	External Memory Space (Region 3)

图 5-2. FSS 内存区域

5.5 闪存编程故障

闪存擦除和写入失败的原因如下：

1. 在执行写入操作之前，没有擦除发出写入操作的扇区或块。
2. 对于配置的协议，SysConfig 中的写入/擦除命令集不正确。一些闪存具有用于 3 字节和 4 字节寻址的不同命令。
3. 定义的闪存程序和闪存繁忙超时过低。
4. 如 [图 5-2](#) 中所述，默认选择的地址范围 0x60000000 必须标记为严格排序、而不是缓存。将区域标记为缓存会导致写入失败。

6 请求 OSPI 和 FLASH 支持的检查清单

在 [TI E2E™ 论坛](#) 上发布与 OSPI/闪存相关的问题之前，如果能解决以下问题，会很有帮助：

1. 使用了哪款 TI 处理器？
2. 使用的 MCU+ SDK 版本是什么？
3. 测试是在定制电路板还是在 TI EVM 上完成的？
4. 命名定制闪存器件并附上数据表。
5. 是否已通过闪存数据表对 SysConfig 中的值进行了验证？
6. 按照[此处](#)的调试指南共享故障日志或故障点。
7. 指向本应用手册中的特定部分，进一步了解在测试电路板上观察到的故障。

7 摘要

本应用手册为使用 MCU+ SDK 将定制 xSPI 闪存器件与 TI Sitara 处理器进行集成的开发人员提供实用的调试参考。本文档大致介绍了用于诊断和解决引导故障、闪存读取/写入/擦除问题以及器件整体启动挑战的系统方法。其中包括逐步检查、配置指南和验证提示，可帮助工程师快速找出根本原因并加快自定义 DUT 上的系统启动。通过整合常见故障场景和成熟的调试 workflow，本指南可帮助减少集成工作量、并实现定制 NOR 或 NAND 闪存的可靠运行。

8 参考资料

1. 德州仪器 (TI)，[AM62Px Sitara 处理器](#)，数据表。
2. 德州仪器 (TI)，[AM62Px MCU+ SDK](#)。
3. Infineon Technologie，[S28HS512T 数据表](#)。
4. 德州仪器 (TI)，[AM62Px Sitara 处理器技术参考手册](#)，技术参考手册。
5. 德州仪器 (TI)，[AM62x 处理器器件](#)，勘误表。
6. 德州仪器 (TI)，[AM62Dx Sitara 处理器器件勘误表](#)，勘误表。
7. 德州仪器 (TI)，[AM64x/AM243x 处理器器件](#)，勘误表。
8. 德州仪器 (TI)，[AM62L Sitara 处理器器件勘误表](#)，勘误表。
9. 德州仪器 (TI)，[AM62A 处理器器件勘误表](#)，勘误表。
10. 德州仪器 (TI)，[AM62P Sitara 处理器器件勘误表](#)，勘误表。

重要通知和免责声明

TI“按原样”提供技术和可靠性数据（包括数据表）、设计资源（包括参考设计）、应用或其他设计建议、网络工具、安全信息和其他资源，不保证没有瑕疵且不做任何明示或暗示的担保，包括但不限于对适销性、与某特定用途的适用性或不侵犯任何第三方知识产权的暗示担保。

这些资源可供使用 TI 产品进行设计的熟练开发人员使用。您将自行承担以下全部责任：(1) 针对您的应用选择合适的 TI 产品，(2) 设计、验证并测试您的应用，(3) 确保您的应用满足相应标准以及任何其他安全、安保法规或其他要求。

这些资源如有变更，恕不另行通知。TI 授权您仅可将这些资源用于研发本资源所述的 TI 产品的相关应用。严禁以其他方式对这些资源进行复制或展示。您无权使用任何其他 TI 知识产权或任何第三方知识产权。对于因您对这些资源的使用而对 TI 及其代表造成的任何索赔、损害、成本、损失和债务，您将全额赔偿，TI 对此概不负责。

TI 提供的产品受 [TI 销售条款](#)、[TI 通用质量指南](#) 或 [ti.com](#) 上其他适用条款或 TI 产品随附的其他适用条款的约束。TI 提供这些资源并不会扩展或以其他方式更改 TI 针对 TI 产品发布的适用的担保或担保免责声明。除非德州仪器 (TI) 明确将某产品指定为定制产品或客户特定产品，否则其产品均为按确定价格收入目录的标准通用器件。

TI 反对并拒绝您可能提出的任何其他或不同的条款。

版权所有 © 2025，德州仪器 (TI) 公司

最后更新日期：2025 年 10 月